



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출 원 번 호 : 특허출원 2003년 제 0083963 호
Application Number 10-2003-0083963

출 원 년 월 일 : 2003년 11월 25일
Date of Application NOV 25, 2003

출 원 인 : 우응제 외 3명
Applicant(s) WOO EUNG JE, et al.

2004년 12월 6일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【유형】 특허 출원서
【권리구분】 특허
【수신처】 특허청장
【발조번호】 0004
【제출인자】 2003.11.25
【국제특허분류】 G01R
【명의 명칭】 이방성 도전율 및 전류밀도를 영상화하는 시스템 및 방법
【명의 영문명칭】 System and Method for visualizing anisotropic conductivity and current density
【출원인】
【성명】 우승재
【출원인 코드】 4-2000-050251-1
【출원인】
【성명】 권오인
【출원인 코드】 4-2000-050247-1
【출원인】
【성명】 서진근
【출원인 코드】 4-2000-050249-4
【출원인】
【명칭】 학교법인 고황재단
【출원인 코드】 2-1999-901357-1
【대리인】
【성명】 심창섭
【대리인 코드】 9-1998-000279-9
【포괄위임등록번호】 2000-062042-1
【포괄위임등록번호】 2000-062029-6
【포괄위임등록번호】 2000-062039-4
【포괄위임등록번호】 2003-080342-5

[대리인]

【성명】 김용인
 【대리인 코드】 9-1998-000022-1
 【포괄위임 등록번호】 2000-062043-9
 【포괄위임 등록번호】 2000-062033-1
 【포괄위임 등록번호】 2000-062041-4
 【포괄위임 등록번호】 2003-080343-2

[증명자]

【성명】 우승재
 【출원인 코드】 4-2000-050251-1

[증명자]

【성명】 권오인
 【출원인 코드】 4-2000-050247-1

[증명자]

【성명】 서진근
 【출원인 코드】 4-2000-050249-4

[증명구]

【증명】
 특허법 제42조의 규정에 의한 출원. 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사 를 청구합니다. 대리인
 심정섭 (인) 대리인
 김용인 (인)

[수수료]

【기본출원료】	20	면	29,000 원
【기산출원료】	5	면	5,000 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	8	항	365,000 원
【합계】	399,000 원		
【감면사유】	학교		
【감면 후 수수료】	199,500 원		
【부서류】	1. 요약서·영세서(도면)_1종		

【요약서】

【약】

본 발명은 측정대상의 도전율이 이방성 (anisotropic)일 때, 상기 측정대상의 이성 도전율을 영상화하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 측정대상 내에 입된 전류에 의해 발생되는 자속밀도의 한 방향 성분을 측정하고, 상기 측정된 자밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정대상 내부의 이방성 도전율의 방향 성분을 계산한다. 그리고, 상기 계산된 이방성 도전율의 방향 성분들을 이용하여 상기 측정대상 내부를 영상화한다.

【표도】

도 1

【인어】

양성 도전율, 전류밀도, MRI

【명세서】

【발명의 명칭】

이방성 도전율 및 전류밀도를 영상화하는 시스템 및 방법{System and Method for visualizing anisotropic conductivity and current density}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 도전율 및 전류밀도 영상화 시스템을 나타낸 도면

도 2는 도 1의 전류주입수단의 일 실시예를 나타낸 도면

도 3a 및 3b는 도 1의 전류주입수단의 다른 실시예를 나타낸 도면

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

100 : 전류주입수단	200 : MRI 장치
300 : 연산부	400 : 디스플레이 수단
500 : 전류원	21,31 : 전극
23,33 : 도선	25,35 : 절연용기
37 : 전해물질	

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 인체나 물체 등과 같은 측정대상 내의 이방성 도전율(또는 저항률)과 전류밀도를 영상화하는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

일반적으로 인체 또는 물체의 내부 구조를 영상화하는데는 X-선, MRI, 초음파 등이 사용되고 있다. 그러나 이를 방법들은 인체 또는 물체의 전기적 특성을 영상화하는 데는 못한다.

이러한 문제를 해결하기 위한 노력으로, 1989년에는 MRI 기술을 활용하여 측정대상 내부의 전류밀도를 영상화하는 기술이 캐나다 토론토대학의 연구팀에 의해 최초로 제안되었고, 그 이후에도 관련된 연구가 활발히 진행되어 왔다. 이것이

CDI (Current Density Imaging) 기술이다. 상기 CDI 기술은 주입된 전류 I 로부터 유도자속밀도 B 를 MRI 기술을 이용하여 측정하고, 암페어법칙인 $\oint \frac{1}{\mu_0} \nabla \times B = I$ 로 전류 I 를 계산하여 내부 전류밀도를 영상화하는 기술이다.

그러나 이 CDI 기술은 3가지 성분 (B_x, B_y, B_z)을 갖는 자속밀도 B 를 얻기 위해서 측정대상을 MRI 장비 내에서 회전시켜야 한다는 단점을 가진다. 이는 MRI 장비 내 측정대상이 위치하고 있을 때, MRI 장비의 특성상 주자장 (main magnetic field)의 방향과 일치되는 방향인 z -방향 성분의 자속밀도 즉 B_z 만이 측정 가능하기 때문이 . 즉 MRI 장비가 한 번에 측정 가능한 성분은 B_z 성분 하나이기 때문에, 기존의 CDI 기술은 세 방향성분의 자속밀도 벡터 값을 모두 획득하기 위하여 MRI 장비 내에 측정대상 (인체 또는 물체)을 회전시켜야 한다는 문제점을 가지고 있다. 상기 회전 문제점으로 인해 기존 CDI 기술을 임상에 적용하기 어렵다.

또한 인체 또는 물체의 전기적 특성을 영상화하기 위한 기존 기술로는, 1970년 말부터 활발히 연구되어온 전기임피던스단층촬영 (EIT : Electrical Impedance Tomography) 기술이 있다. 이 EIT 기술은 측정대상의 전기적 특성을 나타내는 저항률 또는 도전율 영상을 제공한다.

그 EIT 기술은 주로 인체를 측정대상으로 하여, 그 인체의 표면에 여러 개의 전극을 부착하여 인체 내부의 저항률을 영상화한다. 즉 인체의 표면에 부착된 여러 전극을 통해 전류를 인가한 후에 다시 표면에 부착된 전극을 통해 전압을 측정하여 체 내부의 저항률을 영상화하는 기술이다. 이렇게 인체 내부의 저항률에 따라 영상 할 수 있는 것은 혈액, 뼈, 허파, 심장, 뼈 등의 인체 내부의 생체조직들이 서로 다른 전기적 특성을 가지기 때문이다.

그러나 EIT 기술이 가지고 있는 근본적인 결점 때문에, EIT 기술에 의해 복원된 영상은 부정확하고 저해상도만을 지원하였다. 즉 EIT 기술에 의해 측정된 전류-전압 데이터는 인체 내부의 저항률 변화에 지극히 둔감하다는 근본적인 결점을 갖는다. 또 EIT를 통해서는 등방성의 도전율 또는 저항률을 얻기 때문에 인체조직의 특성에 따른 도전율의 방향 변화를 알 수 없다. 예를 들어, 근육과 같은 조직에서는 도전율 방향이 근육의 경에 따라 변화하게 되는데, 등방성의 도전율로부터는 인체 조직에 대한 방향 변화를 알 수가 없다.

[발명이 이루고자 하는 기술적 과제]

본 발명의 목적은 상기한 기존의 기술들의 단점을 보완하기 위해 만족한 것으로, 측정대상을 회전시키기 않고도 측정대상의 전기적 특성들(도전율 및 전류밀도)을 영상화하는 데 적당한 도전율 및 전류밀도의 영상화 시스템 및 그 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 근육이 많은 부위의 전기적 특성들을 정확하게 영상 하는 데 적당한 이방성 도전율 및 전류밀도의 영상화 시스템 및 그 방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용】

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 도전을 및 전류밀도의 영상화 시
립은, 측정대상 내에 전류들을 주입하는 다수의 전류주입수단들과, 상기 전류들에
해 상기 측정대상 내에서 발생되는 자속밀도의 한 방향 성분을 측정하는 MRI 장치
. 상기 전류주입수단들로 하여금 상기 측정대상 내에 서로 다른 방향의 전류들을
입하도록 제어하며, 상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정대
내부의 이방성 도전율의 방향 성분들을 계산하는 연산부와, 상기 계산된 이방성
전율의 방향 성분들을 이용하여 상기 측정대상의 내부를 영상화하는 디스플레이 수
을 포함한다.

여기서 상기 연산부는, 임의의 도전율에 상응하는 상기 측정대상의 내부 전압
표면 전압을 계산하고, 상기 계산된 내부 전압과 상기 측정된 자속밀도의 한 방향
분을 이용하여 상기 이방성 도전율의 방향 성분들을 차례로 계산한다.

상기 연산부는 상기 계산된 표면 전압과 실제 표면 전압의 비율에 따라 상기 계
산된 이방성 도전율의 방향 성분을 상수배로 곱하거나 나눈다.

그리고, 상기 연산부는 상기 임의의 도전율의 방향 성분과 상기 계산된 이방성
전율의 방향 성분의 차의 절대값이 설정된 값 이하이면, 상기 계산된 이방성 도전
의 방향 성분을 실제 도전율의 방향성분으로 판단한다.

본 발명의 도전율 및 전류밀도 영상화 방법은, 측정대상 표면에 부착된 전류주
수단들을 통해 상기 측정대상 내부에 서로 다른 방향의 전류들을 공급하는 단계와:
기 전류들에 의해 상기 측정대상 내에서 발생되는 자속밀도의 한 방향 성분을 측정

는 단계와: 상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정대상 내부 이방성 도전율의 방향 성분들을 계산하는 단계와; 상기 이방성 도전율의 방향 성분을 이용하여 상기 측정대상 내부를 영상화하는 단계를 포함한다.

상기 서로 다른 방향의 전류들을 공급하는 단계에서, 상기 전류주입수단 쌍을 레로 선택하고, 상기 선택된 전류주입수단 쌍을 통해 상기 측정대상에 전류를 주입한다.

상기 이방성 도전율의 방향 성분들을 계산하는 단계는, 임의의 도전율에 상응하는 상기 측정대상의 내부 전압 및 표면 전압을 계산하는 단계와; 상기 계산된 내부 압과 상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 이방성 도전율의 방향 성분들을 차례로 계산하는 단계로 이루어진다.

또한, 본 발명의 영상화 방법은, 상기 임의의 도전율의 방향 성분과 상기 계산 이방성 도전율의 방향 성분의 차의 절대값을 계산하고, 상기 계산된 절대값을 설정된 값과 비교하는 단계와, 상기 계산된 표면 전압과 실제 표면 전압의 비율에 따라 상기 계산된 이방성 도전율의 방향 성분을 상수배로 곱하거나 나누는 단계를 더 포함한다. 여기서, 상기 임의의 도전율의 방향 성분과 상기 계산된 이방성 도전율의 방향 성분의 차의 절대값이 설정된 값 이하이면, 상기 계산된 이방성 도전율의 방향 성분을 실제 도전율의 방향성분으로 판단한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명에 따른 영상화 시스템의 구성을 나타낸 도면이다. 도 1에 도시 바와 같이, 본 발명에 따른 영상화 시스템은, 인체나 물체 등과 같은 측정대상 (S) 내부에 여러 방향 ($=1, 2, \dots, N$)의 전류들을 차례로 주입하는 다수의 전류주입수단 00)과, 상기 측정대상 (S) 내부에 주입된 전류들에 따른 상기 측정대상 (S) 내의 속밀도들을 측정하는 MRI 장치 (200)와, 상기 주입된 전류들에 따른 상기 측정대상 1) 표면의 전압과 상기 측정된 자속밀도를 이용하여 상기 측정대상 (S) 내부의 도전 분포 (conductivity distribution)와 전류밀도 분포 (current density distribution)를 계산하는 연산부 (300)와, 상기 측정대상 (S)의 내부를 도전율 (또는 흐름) 영상 및 전류밀도 영상으로 나타내는 디스플레이 수단 (400)과, 상기 전류주입수단 (100)에 전류를 공급하는 전류원 (500)을 포함한다.

상기 전류주입수단 (100)은, 구리와 같은 비자성의 금속이나 도전율이 매우 큰 재료로 이루어진 전극 (21)과, 상기 전극 (21)에 전류를 공급하는 도선 (wire) (23)을 포함한다. 상기 측정대상 (S)의 표면에 상기 전극 (21)을 직접적으로 부착시키는 것이 가능하지만, 상기 측정대상 (S)의 표면 (boundary)에서 자속밀도의 왜곡을 방지하기 위해 상기 전극 (21)을 상기 측정대상 (S)의 표면으로부터 이격 (separate)시키는 것이 바람직하다. 따라서 본 발명의 전류주입수단 (100)의 일실시에는, 도 2에 도시한 바와 같이 상기 전극 (21)을 상기 측정대상 (S)으로부터 이격시키기 위해 상기 전극 (21)과 부되는 절연용기 (25)를 더 포함한다. 상기 절연용기 (25)의 한쪽 면은 상기 전극 (21) 부착되고, 다른 면은 개방된 상태로 상기 측정대상 (S)과 접촉한다. 그리고 상기 절연용기 (25)의 내부에는 전해질 젤이나 전해질 용액을 흡수한 스판지가 삽입되어져 있다. 전해질 젤이나 전해질 용액을 흡수한 스판지는 전극 (21)으로부터 공급되는 전

가 절연용기 (25) 내에 균일하게 흐르게 한다. 이처럼 절연용기 (25)를 이용하여 상 전극 (21)을 측정대상 (S)의 표면으로부터 일정 간격만큼 이격시킴과 동시에 전해질이나 전해질 용액을 흡수한 스판지를 이용하여 상기 측정대상 (S)에 전류를 균일하게 공급함으로써, 전극 (21)과 접촉하는 측정대상 (S)의 표면 근처에서 MRI 영상의 왜곡을 줄일 수 있다.

본 발명의 전류주입수단 (100)의 다른 실시에는, 도 3a 및 3b에 도시한 바와 같이 전극 (31)과, 상기 전극 (31)에 연결된 도선 (33) 와, 상기 전극 (31)을 부착한 구형 (半球形)의 절연용기 (35)를 포함한다. 상기 절연용기 (35)의 한쪽 면은 상기 전극 (31)과 부착되고, 다른 면은 개방된 상태로 상기 측정대상 (S)과 접촉한다. 그리고 기 절연용기 (35)의 내부에는 전해질 젤이나 전해질 용액을 흡수한 스판지 (37)가 삽입되어져 있다.

상기 전류주입수단 (100)들은 측정대상 (S)의 표면에 부착되고, 한번에 한 쌍의 전류주입수단 (100)에만 전류가 흐르게 된다. 따라서 두 개의 전류주입수단 (100)에 의한 상기 측정대상 (S) 내에 전류가 공급된다. 전류주입수단 (100)의 개수를 E라고 가정을 때, 상기 측정대상 (S) 내에 전류를 주입하기 위한 전류주입수단 (100) 쌍에 대한 경우의 수 N은 $E(E-1)/2$ 개이다. 이는 상기 측정대상 (S) 내에서 흐르는 전류 경로의 수와 같다. 상기 전류주입수단 (100)의 쌍 사이의 주입 전류를 I^j ($j=1, 2, \dots, N$)라고 한다. 상기 전류 I^j 는 상기 측정대상 (S) 내에서 전류 밀도 $J^j = (J^j_x, J^j_y, J^j_z)$ 를 발생시킨다.

상기 MRI 장치 (200)는 상기 전류

에 따른 상기 측정대상(S) 내의 자속 밀도 B/z 를 측정한다. 특히, 상기 자속 밀도 B/z 중 상기 MRI 장치(200)의 주자장(main magnetic field)과 평행한 z방향에 해당하는 자속 밀도의 성분 B/z 를 측정한다. 즉, 상기 MRI 장치(200)는 상기 측정대상(S)에 주입된 각 전류($I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$)에 의해 발생하는 자속 밀도 ($B^1z, B^2z, B^3z, \dots, B^nz$)를 측정한다.

상기 연산부(300)는 전류주입수단(100) 쪽을 차례로 선택하며 상기 선택된 전류주입수단(100) 쪽으로 하여금 상기 측정대상(S) 내에 전류를 주입하도록 상기 전류주입수단(100)들을 지어한다. 또한 상기 연산부(300)는 상기 MRI 장치(200)에 의해 측정된 자속 밀도 B/z 를 설정된 알고리즘에 적용하여 상기 측정대상(S) 내부 각 지점에 의한 이방성도전을 A (3×3 행렬로 표현됨)과 전류밀도 J_i 를 계산한다. 여기서, 상기 도전을 A 은 지향률 γ 의 역행열이므로 γ^{-1} 로 표현될 수 있다. 그리고, 상기 디스레이이 수단(400)은 상기 도전을 A 및 전류밀도 J_i 에 따라 상기 측정대상(S)의 내부 각각 영상화한다.

본 발명에 따른 영상화 방법과 그에 이용되는 알고리즘을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

먼저, 도 1에 도시한 바와 같이, 측정대상(S)의 표면 즉, 신체의 표면에 다수의 전류주입수단(100)이 부착된다. 이방성 도전을 A 를 구하기 위해서는 측정대상(S) 내에 차례로 주입되는 전류들은 7가지 이상의 방향으로 주입되어야 하기 때문에 상기 전류주입수단(100)은 적어도 5개 이상 필요하며 적절한 간격으로 배치되어야 한다. 여기서, 상기 이방성 도전을 A 는 다음의 행렬과 같이 표현된다.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

상기 이방성 도전을 A는 9가지의 방향 성분으로 표현되지만 성분 a_{12} 와 a_{21} 이 일하고 성분 a_{13} 과 a_{31} 이 동일하고 성분 a_{23} 과 a_{32} 이 서로 동일하므로 실제로 이 성 도전을 A는 총 6가지 성분을 갖는다. 따라서, 이방성 도전을 A의 6가지 성분을 기 위해서는 적어도 7가지 방향의 전류들이 측정대상(S) 내로 주입되어야 한다. 본 명에서는 7가지 방향의 전류가 측정대상(S) 내로 주입되는 경우를 실시예로 하여 명하기로 한다.

상기 측정대상(S)의 표면에 상기 전류주입수단(100)이 부착된 상태로 상기 측정 상(S)을 MRI 장치(200) 내에 위치시킨 후에, 상기 전류주입수단(100) 쌍을 하나씩 차례로 선택하고, 차례로 선택되는 상기 전류주입수단(100) 쌍을 통해 상기 측정대상(S) 내부에 전류 I^j ($j=1, 2, \dots, 7$)를 차례로 공급한다. 이때, MRI 장치(200)는 상기 측정대상(S) 내에 주입된 각 전류들(I^1, I^2, \dots, I^7)에 의해 각각 발생하는 상기 측정대상(S) 내의 자속 밀도($B^1_z, B^2_z, \dots, B^7_z$)와 상기 측정대상(S)의 표면 전압 V^1, V^2, \dots, V^7 을 측정한다. 상기 MRI 장치(200)는 z 방향에 해당하는 자속 밀도의 성분만을 측정한다. 기서, 상기 표면 전압 V^1, V^2, \dots, V^7 은 상기 선택된 전류주입수단(100) 쌍을 통해 상기 측정대상(S)에 전류가 공급될 때, 선택되지 않은 전류주입수단(100)들과 측정대상(S) 이의 경계면(boundary)에서의 전압이다. 즉, 상기 표면 전압 V^1, V^2, \dots, V^7 은 상기 선택되지 않은 전류주입수단(100)들에 의해 측정된다.

이어, 상기 연산부 (300)는, 상기 전류(I^1, I^2, \dots, I^7)에 의해 발생하는 상기 측정
상 (S)의 표면 전압 V^1, V^2, \dots, V^7 과, 상기 MRI 장치 (200)에 의해 측정된 자속 밀도
 B_z, B^2_z, \dots, B^7_z 를 설정된 알고리즘에 적용하여 상기 측정대상 (S) 내부의 이방성 도
율 A와 전류밀도 J^i 를 계산한다.

상기 자속밀도 B_z 및 상기 표면 전압 V^1, V^2, \dots, V^7 을 이용하여 측정대상 (S) 내부의
방성 도전율 A와 전류밀도 J^i 를 계산하는 알고리즘에 사용되는 수학식들은 다음과
다.

S : 측정대상

∂S : 측정대상의 표면

g^i : 측정대상 표면에서 주입전류에 의한 전류밀도 성분

\mathbf{n} : 측정대상 표면에서의 법선 벡터

ν : 주입전류에 의해 발생하는 측정대상 내의 전압

임피어 법칙으로부터 유도된 수학식 $\frac{1}{\mu_0} \nabla^2 B = \nabla \times J$ 과 Ohm의 법칙 으로부터
도된 수학식 $J = -A \nabla V$ 을 이용하여 자속밀도 B_z 에 대해 표현하면 다음의 수학식 1
같다. 여기서, μ_0 는 자유공간에서의 투자율 (magnetic permeability)이다.

$$\text{수학식 1]} \quad \frac{1}{\mu_0} \begin{bmatrix} \nabla^2 B_1^1 \\ \vdots \\ \nabla^2 B_7^7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \partial_x V^1 \partial_y V^1 \partial_z V^1 \partial_x^2 V^1 - \partial_y^2 V^1 \partial_x \partial_y V^1 \partial_x \partial_z V^1 - \partial_y \partial_z V^1 \\ \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \\ \partial_x V^2 \partial_y V^2 \partial_z V^2 \partial_x^2 V^2 - \partial_y^2 V^2 \partial_x \partial_y V^2 \partial_x \partial_z V^2 - \partial_y \partial_z V^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\partial_z \sigma_{11} + \partial_x \sigma_{12} \\ -\partial_x \sigma_{12} + \partial_z \sigma_{22} \\ -\partial_y \sigma_{13} + \partial_x \sigma_{23} \\ \sigma_{12} \\ -\sigma_{11} + \sigma_{22} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{bmatrix}$$

여기서, $\frac{1}{\mu_0} \begin{bmatrix} \nabla^2 B_s^1 \\ \vdots \\ \nabla^2 B_s^7 \end{bmatrix}$ 를 \mathbf{b} 라 하고.

$$\begin{bmatrix} \partial_x V^1 \partial_y V^1 \partial_z V^1 \partial_x^2 V^1 - \partial_y^2 V^1 \partial_x \partial_y V^1 \partial_x \partial_z V^1 - \partial_y \partial_z V^1 \\ \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \\ \partial_x V^2 \partial_y V^2 \partial_z V^2 \partial_x^2 V^2 - \partial_y^2 V^2 \partial_x \partial_y V^2 \partial_x \partial_z V^2 - \partial_y \partial_z V^2 \end{bmatrix} \text{를 } \mathbf{s} \text{라 하면 } \text{상기 수학식 } 1 \text{은 } \mathbf{b}$$

\mathbf{Us} 로 표현될 수 있다.

상기 MRI 장치 (200)에 의해 측정된 자속밀도 Biz 와 상기 측정대상 (S) 내부의 전 V^j ($j=1, 2, \dots, 7$)를 상기 수학식 1에 대입하면 상기 \mathbf{s} 를 유도할 수 있다. 그러나 상 측정대상 (S) 내부의 전압 V^j 를 알지 못하면 상기 측정대상 (S) 내의 실제 도전율을 τ 한 수 없다. 상기 측정대상 (S) 내부의 전압 V^j 는 측정이 불가능하므로 이를 구하 위해 수학식 3을 이용한 반복알고리즘을 사용한다. 상기 \mathbf{s} 를 이용하면 이방성 도 \mathbf{A} 의 한 성분 “”을 제외한 나머지 모든 성분들을 구할 수 있다. 다시 말해서 방향의 도전율 성분을 제외한 나머지 성분들 ($\sigma_{11}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{22}, \sigma_{23}$)을 구한다.

상기 이방성 도전율 \mathbf{A} 의 성분 “”을 구하기 위해서는 다음의 수학식 2를 이용 한다. 수학식 1을 이용하여 계산된 도전율 성분들 $\sigma_{11}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{22}, \sigma_{23}$ 과 전압

2. 전류밀도 \mathbf{J}_s , \mathbf{J}_v 의 값을 수학식 2에 대입하여 이방성 도전율 A의 성분 σ_{ij} 를 산한다.

$$\text{수학식 2]} \quad \begin{pmatrix} \partial_x J_x^1 & \partial_x^2 J_x^1 \\ \vdots & \vdots \\ \partial_x J_x^7 & \partial_x^2 J_x^7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{12} \\ \vdots \\ \sigma_{17} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\partial_x J_x^1 - \partial_x J_x^2 - \partial_x (\sigma_{11} \partial_x J_x^1 + \sigma_{12} \partial_x J_x^2) \\ \vdots \\ -\partial_x J_x^7 - \partial_x J_x^8 - \partial_x (\sigma_{11} \partial_x J_x^7 + \sigma_{12} \partial_x J_x^8) \end{pmatrix}$$

여기서, 상기 전류밀도 \mathbf{J}_s 와 \mathbf{J}_v 는 다음의 식들로부터 얻을 수 있다.

$$(J_x, J_y, J_z) = -i \nabla \psi \cdot \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_x \psi \\ \partial_y \psi \\ \partial_z \psi \end{bmatrix}$$

$$-\frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times \begin{bmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{bmatrix}$$

수학식 2로부터 ψ 를 계산하기 위해선 상기 측정대상 (S) 내부의 전압 V 의 값 알아야한다. V 의 값의 계산은 수학식 3과 고전적인 반복법을 이용한다.

수학식 3] $\nabla \cdot (A \nabla V^j) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, 7)$

$$-A \nabla V^j \cdot n = g^j$$

여기서, 상기 전류밀도 성분 g^j 은 선택된 전류주입수단 (100) 쌍과 접촉하지 않 측정대상 (S)의 표면에서 제로 (0)값을 갖는다. 상기 이방성 도전율 A와 주입전류 i , 그리고 상기 전류주입수단 (100)들의 배치를 알게되면 FEM (finite element method) 와 같은 계산 방법으로 상기 수학식 3로부터 V 를 얻을 수 있다.

그러나, 수학식 3을 이용하여 ν 를 구하기 위해선 이방성 도전을 A 를 알아야 하면, 수학식 1과 수학식 2를 이용하여 A 를 구하기 위해선 ν 를 구해야 한다. 상기 수학식 1(수학식 1, 수학식 2, 수학식 3)을 이용하여 상기 연산부 (300)가 도전을 A 전압 B 를 계산하는 과정은 다음과 같다.

임의로 초기 도전을 A 를 설정하고, 아래의 수학식 3에 상기 초기 도전을 A 상기 측정대상 (S) 표면에서의 전류밀도 성분 g' 을 대입하여 상기 측정대상 (S) 내 및 표면에서의 전압 V_{∞} 과 V_{∞}^j 을 계산한다. 여기서, 상기 초기 도전을 A 는 모든 방향 성분이 균일하다는 가정 하에 동일 값으로 설정되거나 또는 인체 조직별로 알려져 있는 도전율의 방향 성분들 값으로 설정된 수 있다. 그리고 상기 전압들은 임의로 설정된 초기 도전을 A 를 이용하여 계산된 전압들이다. 상기 초기 도전을 A 는 여기서, 상기 전류밀도 성분 g' 는 상기 전류 I^j ($j=1,2,\dots,7$)에 의 알 수 있다.

수학식 4] $\nabla \cdot (A \nabla V_{\infty}^j) = 0 \quad (j=1,2,\dots,7)$

$$-A \nabla V_{\infty}^j \Big|_{\partial S} \cdot n = g'$$

임의의 초기 도전을 A 를 이용하여 상기 측정대상 (S)의 전압 V_{∞}^j 이 구해진 후, 상기 전압 V_{∞}^j 값과 상기 측정된 자속밀도 $B^j z$ 값을 상기 수학식 1에 대입하여 이방성 도전을 A 의 성분들을 계산한다.

상기 계산된 이방성 도전을 A_{m+1} 의 방향성분들은 초기 도전을 A_m 의 방향 성분에 비하여 실제의 도전을 값에 더 가까워진다. 왜냐하면, 상기 계산된 도전을 A_{m+1} 은 상기 측정대상 (S) 내부의 실제 자속밀도 B/z 가 고려된 값이기 때문이다.

본 발명에서는 한층 더 신제 도전을 가까운 도전을 얻기 위해 반복 iteration) 형태의 알고리즘을 이용한다. 즉, 다음의 수학식 $\|A_{m+1} - A_m\| < \epsilon$ 과 같이, 전 단계의 도전을 A_m 의 방향 성분과 상기 계산된 도전을 A_{m+1} 의 해당 성분간의 이를 계산하고, 상기 계산된 값이 설정된 값 ϵ 보다 작은지를 판단한다. 이때 상 계산된 값이 설정된 값 ϵ 보다 크다면 작아질 때까지 ϵ 값을 증가시켜 상승한 바 감이 상기 수학식 4과 수학식 1, 수학식 2를 반복 계산한다. 만약, 상기 이전 단의 도전을 A_m 의 성분과 상기 계산된 도전을 A_{m+1} 의 성분간의 차가 설정된 값 ϵ 보다 작으면 상기 이방성 도전을 A_{m+1} 의 성분들을 실제 도전을의 방향 성분들로 여고, 상기 도전을 A_{m+1} 을 이용하여 상기 측정대상 (S) 내부를 영상화한다.

그러나 상기 계산된 이방성 도전을 A_{m+1} 의 성분들이 실제 자속밀도 B/z 를 고려 서 얻어진 것이라 해도 실제 도전을과 다를 수 있다. 즉, 상기 계산된 이방성 도전 A_{m+1} 은 상기 자속밀도 B/z 에 따라 다른 값을 갖지만 실제 도전을에 비해 상수 배수를 크거나 작을 수 있다. 실제 도전을에 대한 상기 계산된 도전을 A_{m+1} 성분들의 수 배 차이를 제거하기 위해 본 발명에서는 상기 측정된 표면 전압 V_{m+1} 과 상기 산된 표면 전압 V_{m+1}' 을 이용하여 상기 이방성 도전을 A_{m+1} 의 성분들을 스케일 (scale)하는 과정을 추가할 수 있다. 다시 말해서, 상기 측정된 표면 전압 V_{m+1} 과

· 기 계산된 표면 전압 V_{surf} 의 비율에 따라 상기 이방성 도전율 λ_{surf} 을 상수 때
곱하거나 나눈다. 이로써 보다 더 정확한 도전율 값을 얻을 수 있다.

이후, 상기 이방성 도전율 λ_{surf} 의 성분들을 상기 수학식 4에 대입하여 그에 대
하는 전압, 즉 상기 측정대상 (S) 내부의 전압 V 를 계산하고, 상기 도전율 λ_{surf} 의
성분들과 상기 전압 V 를 이용하여 전류밀도 J 를 계산한다. 그리고, 상기 전류밀도
를 이용하여 상기 측정대상 (S) 내부를 영상화한다.

발명의 효과】

상승한 비와 같이, 본 발명은 인체 또는 물체 등과 같은 측정대상을 MRI 장치
에서 회전시키지 않고도 측정대상 내부의 도전율 영상 및 전류밀도 영상을 얻을 수
다.

또한, 전류주입수단을 기존의 MRI 장치와 함께 사용함으로써, 기존의 MRI 장치
으로는 얻을 수 없었던 측정대상 내부의 도전율 및 전류밀도를 얻을 수 있으며, 이
이용하여 고화질의 영상을 재현할 수 있다. 게다가 인체 내의 각 지점에서 도전율
방향성분을 알 수 있기 때문에 근육과 같은 인체조직에서의 도전율을 보다 정확하
측정할 수 있다.

또한, 본 발명의 도전율 영상 및 전류밀도 영상을 기존의 의료장비에 적용시킬
있다. 따라서 생리작용에 따라 생체조직의 저항률이 변하는 장기들을 대상으로 한
능영상 (functional imaging)을 제공할 수 있으며 이로 인해 새로운 의료 검진 기술
확보할 수 있다. 예를 들어, 호흡에 따른 폐의 용적 측정 (폐에 공기가 흡입될 때
배출될 때의 폐 내부의 저항률이 달라짐을 이용한 측정)이나, 심장의 심박출량 측

· 위장기능의 측정, 방광 잔료량 측정, 관절 치유상태의 측정, 또는 뇌기능 측정
에 필요한 영상을 제공할 수 있다.

그리고, 인체조직의 전기적인 특성을 정량적으로 알 수 있으므로 각종 전자기
경/근육 자극기 (electric/magnetic stimulator), 세동 제거기 (defibrillator), 심
조율기 (cardiac pacemaker) 등 전자기 에너지를 이용하는 진단기기나 치료기기의
적화가 가능해진다.

이상에서 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니
는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서 본 발명
기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특히 청구의 범위
의해 정해져야 한다.

【허청구범위】

【구항 1】

측정대상 내에 전류들을 수입하는 다수의 전류주입수단들과.

상기 전류들에 의해 상기 측정대상 내에서 발생되는 자속밀도의 한 방향 성분

측정하는 MRI 장치와.

상기 전류주입수단들로 하여금 상기 측정대상 내에 서로 다른 방향의 전류들을
입하도록 제어하며, 상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정대
내부의 이방성 도전율의 방향 성분들을 계산하는 연산부와.

상기 계산된 이방성 도전율의 방향 성분들을 이용하여 상기 측정대상의 내부를
상화하는 디스플레이 수단을 포함하는 도전율 및 전류밀도 영상화 시스템.

【구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 연산부는,

임의의 도전율에 상응하는 상기 측정대상의 내부 전압 및 표면 전압을 계산하고
상기 계산된 내부 전압과 상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기
방성 도전율의 방향 성분들을 차례로 계산함을 특징으로 하는 도전율 및 전류밀도
상화 시스템.

【구항 3】

제 2 항에 있어서,

상기 연산부는,

수학식

$$\mathbf{B}^1 = \begin{bmatrix} \nabla^2 B_1^1 \\ \vdots \\ \nabla^2 B_n^1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \partial_x V^1 & \partial_y V^1 & \partial_z V^1 & \partial_x^2 V^1 & \partial_x \partial_y V^1 & \partial_x \partial_z V^1 & \partial_y \partial_z V^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_x V^2 & \partial_y V^2 & \partial_z V^2 & \partial_x^2 V^2 & \partial_x \partial_y V^2 & \partial_x \partial_z V^2 & \partial_y \partial_z V^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\partial_x \sigma_{11} + \partial_z \sigma_{12} \\ -\partial_x \sigma_{12} + \partial_z \sigma_{22} \\ -\partial_y \sigma_{12} + \partial_z \sigma_{23} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{bmatrix}$$

예상기 계산된 내부 전압들 (V^1, V^2, \dots, V^n)과 상기 자속밀도의 한 방향 성분들 (B^1

B^2, \dots, B^n)을 대입하여 상기 이방성 도전율의 방향 성분들

$\sigma_{11}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{22}, \sigma_{23}$ 을 계산함을 특징으로 하는 도전율 및 전류밀도 영상화 시

템.

방구형 4)

제 2 항에 있어서,

상기 연산부는,

상기 계산된 내부 전압과 상기 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정

상 내부의 전류밀도를 계산하고, 상기 계산된 내부 전압 (V^1, V^2, \dots, V^n)과 상기 전류

도 \mathcal{J}^1 과 \mathcal{J}^2 을 수학식

$$\begin{pmatrix} \partial_x V^1 & \partial_x^2 V^1 \\ \vdots & \vdots \\ \partial_x V^2 & \partial_x^2 V^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \vdots \\ \sigma_{1N} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\partial_x J_x^1 - \partial_x J_y^1 - \partial_x (\sigma_{11} \partial_x V^1 + \sigma_{12} \partial_x V^2) \\ \vdots \\ -\partial_x J_x^2 - \partial_x J_y^2 - \partial_x (\sigma_{12} \partial_x V^1 + \sigma_{22} \partial_x V^2) \end{pmatrix}$$

에 대입하여 상기 이방성 도전율의 방향 성분 ("))을 계산함을 특징으로 하는 전율 및 전류밀도 영상화 시스템.

구항 5)

측정대상 표면에 부착된 전류주입수단들을 통해 상기 측정대상 내부에 서로 다른 방향의 전류들을 공급하는 단계와:

상기 전류들에 의해 상기 측정대상 내에서 발생되는 자속밀도의 한 방향 성분 측정하는 단계와:

상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정대상 내부의 이방성 전율의 방향 성분들을 계산하는 단계와:

상기 이방성 도전율의 방향 성분들을 이용하여 상기 측정대상 내부를 영상화하는 단계를 포함하는 도전율 및 전류밀도 영상화 방법.

구항 6)

제 5 항에 있어서.

상기 이방성 도전율의 방향 성분들을 계산하는 단계는.

임의의 도전율에 상응하는 상기 측정대상의 내부 전압 및 표면 전압을 계산하는 단계와:

상기 계산된 내부 전압과 상기 측정된 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상이방성 도전율의 방향 성분들을 차례로 계산하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하도전율 및 전류밀도 영상화 방법.

【구항 7】

제 6 항에 있어서.

수학식

$$\begin{aligned} \mathbf{1} & \begin{bmatrix} \nabla^2 B_x \\ \vdots \\ \nabla^2 B_z \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \partial_x V^1 & \partial_x V^1 & \partial_x V^1 & \partial_x^2 V^1 & \partial_x \partial_y V^1 & \partial_x \partial_z V^1 & -\partial_y \partial_z V^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_x V^2 & \partial_x V^2 & \partial_x V^2 & \partial_x^2 V^2 & \partial_x \partial_y V^2 & \partial_x \partial_z V^2 & -\partial_y \partial_z V^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\partial_x \sigma_{11} + \partial_x \sigma_{12} \\ -\partial_x \sigma_{12} + \partial_x \sigma_{22} \\ -\partial_x \sigma_{13} + \partial_x \sigma_{23} \\ \sigma_{12} \\ -\sigma_{11} + \sigma_{22} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

에 상기 계산된 내부 전압들 (V^1, V^2, \dots, V^7)과 상기 자속밀도의 한 방향
분들 ($B_x^1, B_x^2, \dots, B_x^7$)을 대입하여 상기 이방성 도전율의 방향 성분들
 $\sigma_{11}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{22}, \sigma_{23}$ 을 계산함을 특징으로 하는 도전율 및 전류밀도 영상화
법.

【구항 8】

제 6 항에 있어서.

상기 계산된 내부 전압과 상기 자속밀도의 한 방향 성분을 이용하여 상기 측정

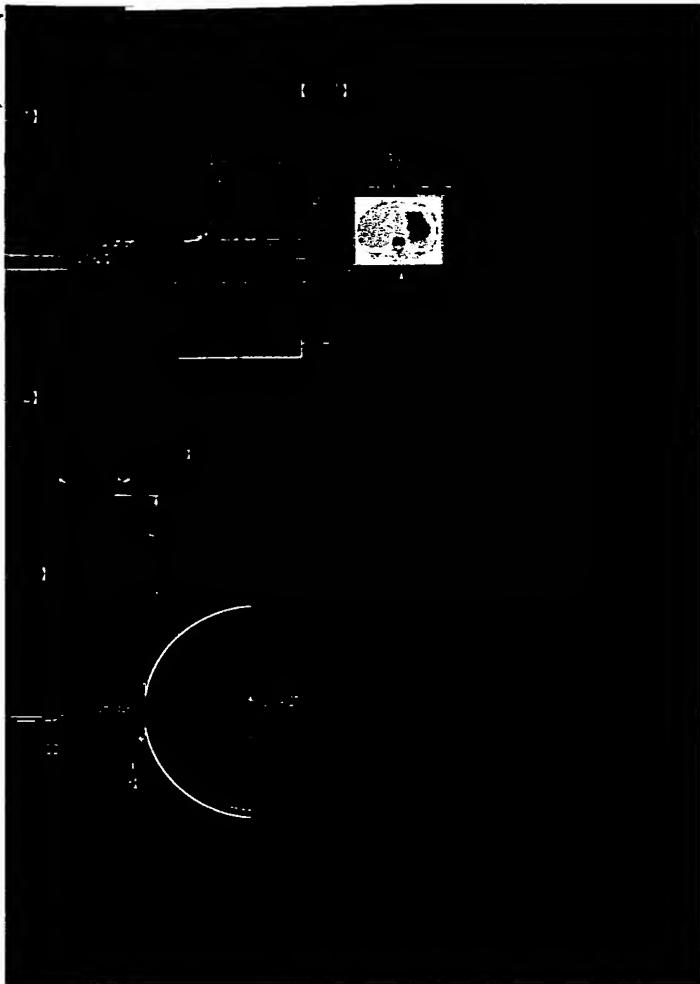
상 내부의 전류밀도를 계산하고, 상기 계산된 내부 전압(V_1, V_2, \dots, V_n)과 상기 전류

도 σ_1 와 σ_2 를 수학식

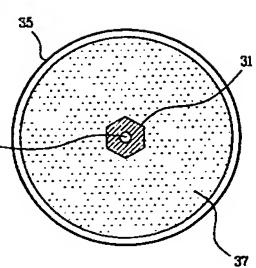
$$\begin{bmatrix} \partial_x V^1 & \partial_x^2 V^1 \\ \vdots & \vdots \\ \partial_x V^2 & \partial_x^2 V^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\partial_x J_x^1 - \partial_x J_y^1 - \partial_x (\sigma_{11} \partial_x V^1 + \sigma_{21} \partial_y V^1) \\ \vdots \\ -\partial_x J_x^2 - \partial_x J_y^2 - \partial_x (\sigma_{12} \partial_x V^2 + \sigma_{22} \partial_y V^2) \end{bmatrix}$$

에 대입하여 상기 이방성 도전율의 방향 성분(σ_{11}, σ_{21})을 계산함을 특징으로 하는

전율 및 전류밀도 영상화 방법.



E 3b}



26-26

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.